汕头华汕电子器件有限公司

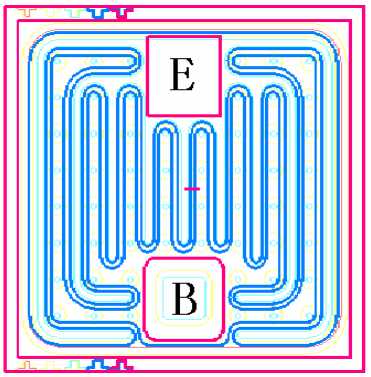
NPN SILICON TRANSISTOR

3279 晶体管芯片说明书

■ 芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
芯片代码：C075AJ-01
芯片厚度：240± 20μm
管芯尺寸：750×750μm^2
焊位尺寸：B 极 165×170μm^2；E 极 150×165μm^2
电极金属：铝
背面金属：金
典型封装：2SC3279

■ 管芯示意图



■ 极限值（T_a=25℃）（TO-92）

T_{stg}——贮存温度……-55~150℃
T_j——结温…… 150℃
P_C——集电极功率耗散（T_a=25℃）……750mW
V_{CBO}——集电极—基极电压……30V
V_{CEO}——集电极—发射极电压……10V
V_{EBO}——发射极—基极电压……6V
I_C——集电极电流……2A
I_B——基极电流……0.2A

■ 电参数（T_a=25℃）（TO-92）

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	30			V	I_C=1mA，I_E=0
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	10			V	I_C=10mA，I_B=0
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	6			V	I_E=1mA，I_C=0
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			0.1	μA	V_{CB}=30V，I_E=0
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			0.1	μA	V_{EB}=6V，I_C=0
h_{FE}	直流电流增益	140		600		V_{CE}=1V，I_C=500mA
		70				V_{CE}=1V，I_C=2A
V_{CE}(sat)	集电极—发射极饱和电压			0.82	V	I_C=2A，I_B=50mA
V_{BE}(on)	基极—发射极饱和电压			1.5	V	V_{CE}=1V，I_C=2A
f_T	特征频率		150		MHz	V_{CE}=1V，I_C=500mA
C_{ob}	共基极输出电容		27		pF	V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz